

附錄七

法定及一般資料

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2009年1月7日根據中國法律成立為有限公司，並隨後於2022年11月8日改製為股份有限公司。我們的註冊辦事處位於中國廣東省東莞市松山湖園區工業北一路5號。

本公司已於中國香港設立主要營業地點(地址為香港中環皇后大道中5號衡怡大廈28樓)，並於2024年12月4日根據公司條例第16部在中國香港註冊為一家非香港公司。本公司已根據公司條例委任德恒律師事務所(香港)有限法律責任合夥為其在中國香港接收法律程序文件及通知的授權代表。本公司於中國香港接收法律程序文件的地址與上文所載我們於中國香港的主要營業地點相同。

由於本公司於中國註冊成立，我們須遵守中國相關法律法規。中國法律法規有關方面及組織章程細則的概要載於本文件附錄六及七。

2. 本公司的股本變動

於本公司成立日期，我們的初始註冊資本為人民幣10,000,000元。於最後實際可行日期，我們的股本為人民幣363,198,011元，包括363,198,011股每股面值人民幣1.00元的已發行非上市股份，已全數繳足。

除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，緊接本文件日期前的兩年內，本公司的股本並無發生任何變動。

緊隨[編纂]及非上市股份轉換為H股完成後，假設[編纂]未獲行使，我們的已發行股本將增至人民幣[編纂]元，分為[編纂]股非上市股份及[編纂]股H股，每股面值為人民幣1.00元，均已繳足或入賬列為繳足，分別佔我們經擴大股本約[編纂]%及[編纂]%。

附錄七

法定及一般資料

3. 本公司的股東決議案

根據於2024年11月29日舉行的股東大會，股東正式通過以下決議案(其中包括)：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，而該等H股將於聯交所[編纂]；
- (b) 於[編纂]獲行使前將予發行的H股數目應為[編纂]完成(根據上市規則滿足最低適用[編纂]要求)及授予[編纂]不超過上述將予發行H股數目[編纂]%的[編纂]後本公司經擴大股本的約[編纂]%；
- (c) 於[編纂]完成後，合共[編纂]股非上市股份將按一換一基準轉換為H股；
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的組織章程細則；及
- (e) 授權董事會及其授權人士處理與(其中包括)[編纂]、發行H股及H股於聯交所[編纂]有關的所有事宜。

4. 我們附屬公司的註冊資本變動

我們的附屬公司名單載列於全文載於本文件附錄一的會計師報告附註14。

除本文件「歷史、發展及公司架構 — 企業發展 — 我們的附屬公司」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們任何附屬公司的股本概無變動。

5. 股份購回的限制

有關對本公司股份購回限制的詳情，請參閱本文件附錄六所載的「組織章程細則概要」一節。

附錄七

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

我們於緊接本文件日期前兩年內已訂立下列重大或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) (1)本公司、(2)李先生、(3)歐陽先生、(4)李玉明、(5)莊樹廣、(6)袁毅、(7)鼎弘投資、(8)旺和投資、(9)潤生投資、(10)哈勃科技、(11)尚頌匯鑄、(12)嘉興頌盈、(13)比亞迪及(14)創啟開盈訂立日期為2024年11月29日的《股東協議》之補充協議，內容有關（其中包括）終止尚頌匯鑄、嘉興頌盈、比亞迪及創啟開盈因彼等各自對本公司的投資而獲授的特別權利的協議；
- (b) (1)本公司、(2)李先生及(3)中國 — 比利時基金訂立日期為2024年11月29日的關於《增資協議》之補充協議，內容有關（其中包括）終止中國 — 比利時基金因其對本公司的投資而獲授的特別權利的協議；
- (c) (1)本公司、(2)李先生、(3)春陽久泰及(4)氫毅昕陽訂立日期為2024年11月29日的關於《增資協議》之補充協議，內容有關（其中包括）終止春陽久泰及氫毅昕陽因彼等各自對本公司的投資而獲授的特別權利的協議；
- (d) (1)本公司、(2)李先生、(3)立灣投資、(4)中廣源及(5)立灣優選訂立日期為2024年11月29日的關於《增資協議》之補充協議，內容有關（其中包括）終止立灣投資、中廣源及立灣優選因彼等各自對本公司的投資而獲授的特別權利的協議；
- (e) (1)本公司、(2)李先生、(3)粵科鑫泰及(4)縉雲天域訂立日期為2024年11月29日的關於《增資協議》之補充協議，內容有關（其中包括）終止粵科鑫泰及縉雲天域因彼等各自對本公司的投資而獲授的特別權利的協議；

附錄七

法定及一般資料

(f) (1)本公司、(2)李先生及(3)立灣倍增訂立日期為2024年11月29日的關於《股份認購協議》之補充協議，內容有關(其中包括)終止立灣倍增因其對本公司的投資而獲授的特別權利的協議；及

(g) [編纂]。

2. 我們的重大知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大的商標：

序號	商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	有效期
1.		本公司	新加坡	9 35	40202317560V	2023年8月10日至 2033年8月9日
2.	TYSiC	本公司	澳洲	9 35	2378593 2378602	2023年8月9日至 2033年8月9日
3.		本公司	澳洲	9 35	2378618 2378608	2023年8月9日至 2033年8月9日
4.	天域	本公司	澳洲	9	2378614	2023年8月9日至 2033年8月9日
5.	天域	本公司	中國香港	9 35	306319125	2023年8月10日至 2033年8月9日
6.	TYSiC	本公司	中國香港	9 35	306319189	2023年8月10日至 2033年8月9日
7.		本公司	中國香港	9 35	306319107	2023年8月10日至 2033年8月9日
8.	TYSiC	本公司	中國	9 35	41688924 41707333	2020年6月21日至 2030年6月20日
9.	天域	本公司	中國	9	23312397	2018年3月14日至 2028年3月13日
10.	 TYSiC	本公司	中國	9	23313330	2020年1月28日至 2030年1月27日
11.	TYSTC	本公司	中國	35	17133179	2016年8月21日至 2026年8月20日

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊編號	有效期
12.	天域	本公司	中國	9	9562768	2023年1月28日至 2033年1月27日
13.		本公司	中國	9	9562655	2024年1月14日至 2034年1月13日
14.	天域	本公司	英國	9 35	UK00004099564	2024年9月13日至 2034年9月12日
15.		本公司	英國	9 35	UK00004099587	2024年9月13日至 2034年9月12日
16.	TYSiC	本公司	英國	9 35	UK00004099573	2024年9月13日至 2034年9月12日
17.	召芯	南方半導體	中國	9	38775463	2020年2月7日至 2030年2月6日
18.	CWBG	南方半導體	中國	9	39757628	2020年4月14日至 2030年4月13日
19.		本公司	韓國	9	40-2305255	2025年1月21日至 2035年1月20日
20.		本公司	韓國	35	40-2305254	2025年1月21日至 2035年1月20日
21.	TYSiC	本公司	韓國	35	40-2305256	2025年1月21日至 2035年1月20日
22.	TYSiC	本公司	韓國	9	40-2305257	2025年1月21日至 2035年1月20日
23.	天域	本公司	韓國	35	40-2305251	2025年1月21日至 2035年1月20日
24.	天域	本公司	韓國	9	40-2305253	2025年1月21日至 2035年1月20日

附錄七

法定及一般資料

(b) 專利

(i) 截至最後實際可行日期，我們已註冊84項專利，並載列以下我們認為對業務屬重大的專利之詳情：

序號	專利	註冊擁有人	專利編號	專利類型	註冊地點	申請日期	專利到期日
1.	行星式外延生長設備中托盤的構成方法和裝置	本公司	201110133831.2	發明	中國	2011年5月23日	2031年5月23日
2.	一種垂直式碳化硅高溫氧化裝置	本公司	201210203696.9	發明	中國	2012年6月19日	2032年6月19日
3.	一種水平式碳化硅高溫氧化裝置	本公司	201210226334.1	發明	中國	2012年7月2日	2032年7月2日
4.	一種高溫大面積碳化硅外延生長裝置及處理方法	本公司	201210260432.7	發明	中國	2012年7月25日	2032年7月25日
5.	一種超高溫雙層水冷石英管真空室用雙密封結構	本公司	201310470610.3	發明	中國	2013年10月9日	2033年10月9日
6.	一種SiC外延片的化學機械清洗方法	本公司	201410353373.7	發明	中國	2014年7月23日	2034年7月23日

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	專利編號	專利類型	註冊地點	申請日期	專利到期日
7.	一種真空室用高溫CVD加熱線圈結構	本公司	201611251450.3	發明	中國	2016年12月30日	2036年12月30日
8.	一種大尺寸SiC晶片的背面處理方法	本公司	201710010531.2	發明	中國	2017年1月6日	2037年1月6日
9.	一種降低SiC外延晶片表面三角形缺陷的外延方法	本公司	201710120128.5	發明	中國	2017年3月2日	2037年3月2日
10.	一種去除SiC外延晶片金屬污染或殘留的清洗方法	本公司	201710120161.8	發明	中國	2017年3月2日	2037年3月2日
11.	一種SiC超高壓PiN二極管器件材料的製備方法	本公司	201710459941.5	發明	中國	2017年6月17日	2037年6月17日
12.	一種SiC雪崩光電二極管器件外延材料的製備方法	本公司	201710459925.6	發明	中國	2017年6月17日	2037年6月17日
13.	一種超高壓P溝道SiC IGBT器件材料及其製造方法	本公司	202010439522.7	發明	中國	2020年5月22日	2040年5月22日

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	專利編號	專利類型	註冊地點	申請日期	專利到期日
14.	一種降低外延片堆疊層錯缺陷的外延方法及其應用	本公司	202010439296.2	發明	中國	2020年5月22日	2040年5月22日
15.	一種SiC化學氣相沉積設備反應腔配件清潔方法	本公司	202010452392.0	發明	中國	2020年5月26日	2040年5月26日
16.	一種漸變式PN結材料的製備方法	本公司	202010501945.7	發明	中國	2020年6月4日	2040年6月4日
17.	一種抑制外延邊緣Crown缺陷的方法	本公司	202110771412.5	發明	中國	2021年7月8日	2041年7月8日
18.	一種快速去除碳化硅外延過程中晶片背面沉積物的方法	本公司	202110978852.8	發明	中國	2021年8月25日	2041年8月25日
19.	一種碳化硅外延晶片生長用樣品托上的複合塗層製備方法	本公司	202111107336.4	發明	中國	2021年9月22日	2041年9月22日
20.	一種降低半導體外延片翹曲度的方法	本公司	202210729428.4	發明	中國	2022年6月24日	2042年6月24日

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	專利編號	專利類型	註冊地點	申請日期	專利到期日
21.	一種生長低翹曲半導體基底晶片的方法	本公司	202210729423.1	發明	中國	2022年6月24日	2042年6月24日
22.	一種8英寸單片高溫碳化硅外延生長室結構	本公司	201621419794.6	實用新型	中國	2016年12月21日	2026年12月21日
23.	一種衛星盤自轉的SiC外延生長主盤結構	本公司	201621419760.7	實用新型	中國	2016年12月21日	2026年12月21日
24.	一種可拆卸的組合式拋光盤	本公司	201720061831.9	實用新型	中國	2017年1月17日	2027年1月17日
25.	超摻雜均勻性大面積SiC外延層生長腔室結構	本公司	201720237302.X	實用新型	中國	2017年3月10日	2027年3月10日
26.	一種拋光設備用的配重加壓式環刀型修盤器	本公司	201921570583.6	實用新型	中國	2019年9月20日	2029年9月20日
27.	一種氣缸加壓式環刀型修盤器	本公司	201921570597.8	實用新型	中國	2019年9月20日	2029年9月20日
28.	一種外延爐供氣裝置	本公司	201921368527.4	實用新型	中國	2019年8月20日	2029年8月20日

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	專利編號	專利類型	註冊地點	申請日期	專利到期日
29.	一種改變SiC晶片翹曲度的拋光裝置	本公司	202021000501.9	實用新型	中國	2020年6月3日	2030年6月3日
30.	一種碳化硅化學氣相沉積設備氣體混合裝置	本公司	202121551692.0	實用新型	中國	2021年7月9日	2031年7月9日
31.	一種生長碳化硅外延晶片用樣品托及其裝置	本公司	202121544878.3	實用新型	中國	2021年7月8日	2031年7月8日
32.	一種避免晶圓正面大面積接觸的載物台	本公司	202121597934.X	實用新型	中國	2021年7月14日	2031年7月14日
33.	抑制SiC外延片背面生長白斑或顆粒物的托盤結構	本公司	202121597910.4	實用新型	中國	2021年7月14日	2031年7月14日
34.	一種汞CV磁吸式測試夾具	本公司	202121600230.3	實用新型	中國	2021年7月14日	2031年7月14日
35.	一種碳化硅化學氣相沉積反應器	本公司	202122118366.7	實用新型	中國	2021年9月3日	2031年9月3日
36.	半導體外延生長用托盤	本公司	202221089361.4	實用新型	中國	2022年5月7日	2032年5月7日
37.	外延片托盤	本公司	202221060880.8	實用新型	中國	2022年5月5日	2032年5月5日

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	專利編號	專利類型	註冊地點	申請日期	專利到期日
38.	用於外延生長的托盤	本公司	202221060631.9	實用新型	中國	2022年5月5日	2032年5月5日
39.	一種用於夾取多種尺寸的 半導體碳化硅外延片的 夾子	本公司	202221602714.6	實用新型	中國	2022年6月24日	2032年6月24日
40.	一種用於生長高品質半導體 外延片的配件結構	本公司	202221602761.0	實用新型	中國	2022年6月24日	2032年6月24日
41.	一種冷卻循環水的冷凝 裝置)	本公司	202221539492.8	實用新型	中國	2022年6月20日	2032年6月20日
42.	一種具有複合塗層的碳化硅 外延晶片生長用樣品托	本公司	202122291067.3	實用新型	中國	2021年9月22日	2031年9月22日
43.	用於導電型碳化硅晶片的電 流加熱裝置	本公司	202221248562.4	實用新型	中國	2022年5月20日	2032年5月20日
44.	外延爐裝置	本公司	202221248535.7	實用新型	中國	2022年5月20日	2032年5月20日
45.	管路供應系統	本公司	202221487953.1	實用新型	中國	2022年6月14日	2032年6月14日
46.	碳化硅外延生長管路系統	本公司	202221486035.7	實用新型	中國	2022年6月15日	2032年6月15日

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	專利編號	專利類型	註冊地點	申請日期	專利到期日
47.	一種蝶閥清洗固定與防潑水裝置	本公司	202221908151.3	實用新型	中國	2022年7月22日	2032年7月22日
48.	真空吸筆	本公司	202222776427.3	實用新型	中國	2022年10月20日	2032年10月20日
49.	用於半導體晶片空洞檢測的載台	本公司	202222775929.4	實用新型	中國	2022年10月20日	2032年10月20日
50.	一種用於碳化硅載流子濃度測試儀上的可拆卸探頭	本公司	202223537322.9	實用新型	中國	2022年12月28日	2032年12月28日
51.	一種提高生產效率的碳化硅外延爐托盤取片裝置	本公司	202223536028.6	實用新型	中國	2022年12月30日	2032年12月30日
52.	用於生長半導體外延片的托盤	本公司	202223592696.0	實用新型	中國	2023年1月3日	2033年1月3日
53.	一種製程工藝氣體的導流配件	本公司	202320072195.5	實用新型	中國	2023年1月10日	2033年1月10日
54.	一種能夠自由切換不同大小尺寸的CV測試夾具	本公司	202320221899.4	實用新型	中國	2023年2月15日	2033年2月15日
55.	碳化硅表面粗糙度測試儀卡位器	本公司	202321388527.7	實用新型	中國	2023年6月2日	2033年6月2日

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	專利編號	專利類型	註冊地點	申請日期	專利到期日
56.	石英鐘罩保護裝置	本公司	202323659215.8	實用新型	中國	2023年12月29日	2033年12月29日
57.	一種提高工藝氣體混合均勻性的裝置	本公司	202420558283.0	實用新型	中國	2024年3月21日	2034年3月21日
58.	碳化硅外延片生長載盤	本公司	202420642554.0	實用新型	中國	2024年4月1日	2034年4月1日
59.	碳化硅外延生長承載裝置	本公司	202420642548.5	實用新型	中國	2024年4月1日	2034年4月1日
60.	一種台階式SiC溝槽場限環終端結構、製備方法及其器件	南方半導體	202011034646.3	發明	中國	2020年9月27日	2040年9月27日
61.	數位同步整流控制方法及數位信號處理器	南方半導體	202011458643.2	發明	中國	2020年12月11日	2040年12月11日
62.	軟開關雙向直流變換器的升壓模式恆功率控制方法及電路	南方半導體	202010054157.8	發明	中國	2020年1月17日	2040年1月17日
63.	軟開關雙向直流變換器的升壓模式恆電流控制方法及電路	南方半導體	202010052980.5	發明	中國	2020年1月17日	2040年1月17日

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	專利編號	專利類型	註冊地點	申請日期	專利到期日
64.	軟開關雙向直流變換器的升壓模式恆電壓控制方法及電路	南方半導體	202010052944.9	發明	中國	2020年1月17日	2040年1月17日
65.	操作電源系統及電力電子變壓器系統	南方半導體	201911223450.6	發明	中國	2019年12月3日	2039年12月3日
66.	多路穩壓電源電路及電子設備	南方半導體	201911105636.1	發明	中國	2019年11月13日	2039年11月13日
67.	多相自耦變壓器及整流器系統	南方半導體	202110153886.3	發明	中國	2021年2月4日	2041年2月4日
68.	多相變壓器及整流器系統	南方半導體	202110153893.3	發明	中國	2021年2月4日	2041年2月4日
69.	多相變壓器及整流器系統	南方半導體	202120318756.6	實用新型	中國	2021年2月4日	2031年2月4日
70.	多相自耦變壓器及整流器系統	南方半導體	202120317865.6	實用新型	中國	2021年2月4日	2031年2月4日
71.	功率開關模塊測試箱	南方半導體	202222825003.1	實用新型	中國	2022年10月25日	2032年10月25日
72.	功率開關模塊測試工裝	南方半導體	202222825005.0	實用新型	中國	2022年10月25日	2032年10月25日
73.	芯片輻照測試夾持裝置	南方半導體	202223313585.1	實用新型	中國	2022年12月8日	2032年12月8日

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	註冊擁有人	專利編號	專利類型	註冊地點	申請日期	專利到期日
74.	疊層式功率芯片抗輻照測試夾持裝置	南方半導體	202320510526.9	實用新型	中國	2023年3月15日	2033年3月15日
75.	功率半導體器件熱阻測試工裝	南方半導體	202420433956.X	實用新型	中國	2024年3月6日	2034年3月6日
76.	一種碳化硅外延晶片硅面貼膜後的清洗方法	本公司	202210598538.1	發明	中國	2022年5月30日	2042年5月30日
77.	一種碳化硅外延用上半月石墨件結構	本公司	202323646488.9	實用新型	中國	2023年12月29日	2033年12月29日
78.	一種水平氣流SiC外延設備石英鐘罩內壁清潔工具	本公司	202323646489.3	實用新型	中國	2023年12月29日	2033年12月29日
79.	用於雙層結構生長襯底外延生長的樣品托	本公司	202310291640.1	發明	中國	2023年3月22日	2043年3月22日
80.	一種粘貼吸附墊的裝置	本公司	202420474937.1	實用新型	中國	2024年3月12日	2034年3月12日
81.	晶片測試探頭	本公司	202421073886.8	實用新型	中國	2024年5月17日	2034年5月17日
82.	一種石墨配件清潔輔助治具	本公司	202421122774.7	實用新型	中國	2024年5月22日	2034年5月22日

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利	註冊擁有人	專利編號	專利類型	註冊地點	申請日期	專利到期日
83.	一種具有上料檢測功能的碳化硅外延生長進料設備	本公司	202421122775.1	實用新型	中國	2024年5月22日	2034年5月22日
84.	最大功率點跟蹤控制方法、系統及光伏發電輸出裝置	南方半導體	202310136197.0	發明	中國	2023年2月17日	2043年2月17日

(ii) 截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對業務屬重大的專利：

序號	專利	申請人	申請地點	專利類型	申請編號	申請日期
1.	降低碳化硅外延背景摻雜濃度的方法	本公司	中國	發明	202210503801.4	2022年5月10日
2.	用於導電型碳化硅晶片的電流加熱裝置	本公司	中國	發明	202210549425.2	2022年5月20日
3.	碳化硅外延片的處理方法	本公司	中國	發明	202210596257.2	2022年5月27日
4.	一種碳化硅外延晶片硅面貼膜後的清洗方法	本公司	中國	發明	202210598538.1	2022年5月30日
5.	一種防止磨拋過程中碳化硅外延片表面膠質殘留的方法	本公司	中國	發明	202210611254.1	2022年5月31日
6.	碳化硅外延片去除外延再生襯底的方法	本公司	中國	發明	202210617214.8	2022年6月1日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	申請人	申請地點	專利類型	申請編號	申請日期
7.	碳化硅外延生長管路系統	本公司	中國	發明	202210667129.2	2022年6月14日
8.	管路供應系統	本公司	中國	發明	202210668231.4	2022年6月14日
9.	一種檢測碳化硅外延晶片表面痕量金屬的方法	本公司	中國	發明	202210719450.0	2022年6月23日
10.	矯正碳化硅外延片翹曲度的方法	本公司	中國	發明	202211693602.0	2022年12月28日
11.	一種改善碳化硅外延層基平面位錯的生長方法	本公司	中國	發明	202211729418.7	2022年12月30日
12.	一種清洗碳化硅表面殘留過氧化硅拋光液的方法	本公司	中國	發明	202211729191.6	2022年12月30日
13.	一種高效去除碳化硅襯底晶片污染的清洗方法	本公司	中國	發明	202310012004.0	2023年1月5日
14.	一種碳化硅晶片表面金屬殘留的清洗方法	本公司	中國	發明	202310022126.8	2023年1月7日
15.	外延生長檢測方法	本公司	中國	發明	202310291626.1	2023年3月22日
16.	一種溝槽結構碳化硅的外延填充方法	本公司	中國	發明	202310283692.4	2023年3月22日
17.	一種高效碳化硅外延晶片硅面貼膜後的清洗方法	本公司	中國	發明	202310328225.9	2023年3月30日
18.	一種用於大型碳化硅蠟拋襯底的清洗方法及設備	本公司	中國	發明	202310415600.3	2023年4月18日
19.	應力消除外延生長裝置及外延生長方法	本公司	中國	發明	202311866172.2	2023年12月29日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	申請人	申請地點	專利類型	申請編號	申請日期
20.	一種減少減薄碳化硅紋路的方法	本公司	中國	發明	202311857742.1	2023年12月29日
21.	石墨配件磨光裝置及磨光系統	本公司	中國	發明	202410116046.3	2024年1月26日
22.	一種去除碳化硅外延片揭膜後髒污的清洗方法	本公司	中國	發明	202410280241.X	2024年3月12日
23.	碳化硅外延片的生長工藝	本公司	中國	發明	202410373221.7	2024年3月31日
24.	探頭磨光清潔方法	本公司	中國	發明	202410609502.8	2024年5月16日
25.	改善碳化硅外延片翹曲的方法及托盤	本公司	中國	發明	202410653793.0	2024年5月24日
26.	表面多孔結構的外延層生長方法	本公司	中國	發明	202410663362.2	2024年5月27日
27.	一種碳化硅外延用上半月石墨件結構	本公司	中國	實用新型	202323646488.9	2023年12月29日
28.	碳化硅外延用石墨件	本公司	中國	實用新型	202422011781.6	2024年8月19日
29.	減少接觸面積的測試探頭	本公司	中國	實用新型	202422010914.8	2024年8月19日
30.	一種晶圓手動倒片器	本公司	中國	實用新型	202422040915.7	2024年8月22日
31.	一種研磨CV探頭的鑲嵌式定量磨削夾具	本公司	中國	實用新型	202422004899.6	2024年8月22日
32.	一種水平氣流SiC外延設備石英鐘罩內壁清潔工具	本公司	中國	實用新型	202323646489.3	2023年12月29日
33.	一種碳化硅功率器件終端區表面鈍化方法	南方半導體	中國	發明	202011036141.0	2020年9月27日
34.	基於神經網絡的光伏模組最大功率點跟蹤方法及系統	南方半導體	中國	發明	2022113305996	2022年10月25日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	申請人	申請地點	專利類型	申請編號	申請日期
35.	功率開關模組測試方法	南方半導體	中國	發明	202211316165.0	2022年10月25日
36.	節能電機的設計方法及裝置	南方半導體	中國	發明	202310172698.4	2023年2月17日
37.	碳化硅功率芯片抗輻照測試輔助夾具	南方半導體	中國	發明	202211743028.5	2022年12月30日
38.	功率半導體器件熱阻測試系統及方法	南方半導體	中國	發明	2024102538173	2024年3月6日
39.	適配水冷散熱模組的功率循環測試平台	南方半導體	中國	發明	2024211965426	2024年5月28日
40.	功率半導體器件循環測試固定裝置	南方半導體	中國	發明	202422283795.3	2024年9月18日

(c) 軟件著作權

截至最後實際可行日期，本集團為以下我們認為對業務屬重大且在中國的軟件著作權的註冊擁有人：

序號	軟件名稱	註冊擁有人	註冊編號	註冊日期
1.	中小型變速恆頻無刷雙饋發電機 實時控制軟件	東莞南方半導體 科技有限公司	2020SR1027055	2020年9月2日

附錄七

法定及一般資料

(d) 域名

截至最後實際可行日期，本集團為以下我們認為對業務屬重大的域名的註冊擁有人：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1.	sicthy.com	本公司	2025年12月7日
2.	cwbg-nf.com	南方半導體	2029年9月29日

C. 有關董事及監事的進一步資料

1. 董事及監事合約的詳情

各董事及監事已與本公司訂立服務合約。服務合約可根據組織章程細則及適用法律、規則及法規續期。

除上文所披露者外，概無董事或監事與本集團任何成員公司訂有或擬訂立服務合約（於一年內屆滿或可由相關僱主於一年內終止而毋須支付賠償（不包括法定賠償）的合約除外）。

2. 董事及監事的薪酬

有關於往績記錄期間支付予董事及監事的薪酬或實物福利的詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」一節及附錄一會計師報告附註8。

於往績記錄期間，本集團並無向任何董事、監事或五名最高薪酬人士支付任何袍金作為吸引其加入我們的激勵或離職補償，且概無董事或監事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

附錄七

法定及一般資料

D. 權益披露

1. 董事、監事及本公司最高行政人員的權益披露

緊隨[編纂]完成後，H股一經[編纂]後，董事、監事及本公司最高行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部將須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（如適用）（包括根據證券及期貨條例的該等條文彼等被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條將須登記於該條所指登記冊的權益及／或淡倉（如適用），或根據上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》將須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（如適用）如下：

董事、監事或 本公司最高行政 人員姓名	職位	權益性質	股份說明	於最後實際可行日期及 緊接[編纂]前持有的股份 ⁽¹⁾		緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使)持有的股份 ⁽¹⁾ 於非上市 股份／H股 (如適用)權益的概約 百分比 ⁽²⁾		
				數目	概約百分比	數目	百分比 ⁽²⁾	於本公司 權益的概約 百分比 ⁽²⁾
李先生 ^{(3)及(4)}	主席、執行董事 兼總經理	實益權益	非上市股份	105,517,013 (L)	29.0522%	[編纂] (L)	[編纂]%	[編纂]%
			H股	無	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		於受控法團的權益 ⁽³⁾	非上市股份	40,310,259 (L)	11.0987%	[編纂] (L)	[編纂]%	[編纂]%
			H股	無	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		一致行動人士的權益 ⁽⁴⁾	非上市股份	66,126,373 (L)	18.2067%	[編纂] (L)	[編纂]%	[編纂]%
歐陽先生 ⁽⁴⁾	非執行董事	實益權益	非上市股份	66,126,373 (L)	18.2067%	[編纂] (L)	[編纂]%	[編纂]%
			H股	無	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		一致行動人士的權益 ⁽⁴⁾	非上市股份	145,827,272 (L)	40.1509%	[編纂] (L)	[編纂]%	[編纂]%
			H股	無	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
						[編纂]	[編纂]	[編纂]
莊樹廣先生	監事會主席、股東 代表監事	實益權益	非上市股份	28,139,493 (L)	7.7477%	[編纂] (L)	[編纂]%	[編纂]%
			H股	無	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
袁毅先生	股東代表監事	實益權益	非上市股份	14,057,580 (L)	3.8705%	[編纂] (L)	[編纂]%	[編纂]%
			H股	無	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- 字母「L」表示該實體／人士於該等股份中的好倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

附錄七

法定及一般資料

2. 計算基準為[編纂]時已發行[編纂]股非上市股份及[編纂]股H股的總數，包括(i)將由非上市股份轉換的合共[編纂]股H股及(ii)根據[編纂]將予發行的[編纂]股H股(並無計及因行使[編纂]而可能發行的H股)。
3. 於最後實際可行日期，鼎弘投資、潤生投資及旺和投資分別於20,274,440股非上市股份、11,585,291股非上市股份及8,450,528股非上市股份中擁有權益。鼎弘投資、潤生投資及旺和投資(作為員工持股計劃平台)均由其執行合夥人天域共創管理，而天域共創由李先生及蘇女士(李先生的配偶)分別擁有99%及1%的權益。鼎弘投資、潤生投資及旺和投資各自為有限合夥企業注資超過三分之一的有限合夥人為李先生，其分別持有鼎弘投資、潤生投資及旺和投資34.76%、39.60%及42.62%的合夥權益。因此，根據證券及期貨條例，李先生被視為於鼎弘投資、潤生投資及旺和投資持有的非上市股份中擁有權益。
4. 根據一致行動協議，李先生及歐陽先生承認並確認，彼等應一致行動，根據彼等在本公司董事會及／或股東大會上達成的共識，一致投票，倘彼等未能就所提交之任何事項達成共識，各方應按照李先生之指示進行表決。有關詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構 — 企業發展 — 本公司 — 一致行動安排」。因此，各一致行動人士(即李先生及歐陽先生)均被視為於彼此所擁有權益的股份中擁有權益。

2. 主要股東的權益披露

除本文件「主要股東」一節所披露者外，董事概不知悉任何人士(董事、監事或本公司最高行政人員除外)於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)於我們的股份或相關股份中將擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

3. 免責聲明

除本文件「業務」及「主要股東」章節及本節「C.有關董事及監事的進一步資料」及「D.權益披露」段落所披露者外：

- (a) 概無董事或最高行政人員在本公司發起過程中，或於緊接本文件日期前兩年內於本集團任何成員公司購買或出售或租賃或本集團任何成員公司擬購買或出售或租賃的任何資產中直接或間接擁有任何權益；

附錄七

法定及一般資料

- (b) 概無董事或監事於在本文件日期仍然存續且對本集團整體業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (c) 概無董事於與我們的業務構成或可能直接或間接構成競爭的任何業務(本集團的業務除外)中擁有任何權益；及
- (d) 不計及根據[編纂]可能承購的任何股份，董事並不知悉有任何人士(並非董事或本公司最高行政人員)將於緊隨[編纂]完成後，於本公司股份或相關股份中擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

E. 僱員激勵計劃

我們已於2022年1月22日採納僱員激勵計劃。僱員激勵計劃不受上市規則第17章條文的規限，因為其不涉及本公司於[編纂]後授出股份或授出認購股份的購股權。鑒於僱員激勵計劃項下的相關股份已發行，僱員激勵計劃項下的獎勵歸屬後不會對已發行股份產生攤薄作用。

(a) 目的

僱員激勵計劃旨在激勵參與者長期服務本公司及致力提升本公司價值並培養股東與管理層的長期利益共享意識。

(b) 參與者

僱員激勵計劃的參與者(「參與者」)包括本公司或其附屬公司的董事、高級管理層、核心技術人員及服務骨幹、以及本公司認為合適的對本公司經營業績及未來發展有重大影響的其他人士(獨立非執行董事除外)。

附錄七

法定及一般資料

(c) 管理

董事會獲授權管理僱員激勵計劃，包括但不限於制訂及修訂僱員激勵計劃的實施文件，及選擇員工持股計劃平台的合適管理者。員工持股計劃平台的管理人獲授權管理平台的日常運營，包括(其中包括)管理、維持及分派平台的資產。員工持股計劃平台的執行合夥人天域共創，擔任員工持股計劃平台的管理人。

(d) 授出激勵性獎勵

我們已建立三個員工持股計劃平台，即鼎弘投資、潤生投資及旺和投資，以實施僱員激勵計劃。有關我們員工持股計劃平台的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構 — 我們的員工持股計劃平台」。截至最後實際可行日期，我們的員工持股計劃平台合共持有40,310,259股股份，佔本公司股本約11.10%，其中，鼎弘投資持有的約13,926,512股股份、潤生投資持有的約9,986,521股股份及旺和投資持有的約8,044,057股股份分別對應李先生、歐陽先生、李玉明先生、莊樹廣先生、袁毅先生及天域共創作為員工持股計劃平台初始投資者所持有的合夥權益，由於該等股份屬於員工激勵計劃項下授予參與者的激勵性獎勵，因此不予計算在內。另一方面，8,353,169股股份(佔本公司股本的2.3000%)指作為激勵性獎勵授予參與者的股份。詳情請參閱本節下文「— E. 僱員激勵計劃 — (f) 根據僱員激勵計劃授出的激勵性獎勵詳情」。

參與者認購員工持股計劃平台的有限合夥權益(「**激勵性獎勵**」)，從而憑藉彼等作為相關員工持股計劃平台的有限合夥人的身份間接持有本公司股份。激勵性獎勵將於參與者及時向相關員工持股計劃平台繳付全數認購價及取得員工持股計劃平台管理人的相關書面確認後授予參與者。

(e) 贖回激勵性獎勵

於本公司[編纂]後，倘參與者與本公司的僱傭關係終止且無不當行為，則相關參與者可將其在員工持股計劃平台的合夥權益轉讓予員工持股計劃平台的管理人或由管理人指定的第三方，金額為實際認購價加根據僱員激勵計劃計算的一定利息。

附錄七

法定及一般資料

(f) 根據僱員激勵計劃授出的激勵性獎勵詳情

截至最後實際可行日期，激勵性獎勵相當於合共約8,353,169股股份，約佔我們已發行股份總數的2.3000%，已根據僱員激勵計劃授予95名參與者。除上文所述者外，概無根據僱員激勵計劃進一步授出合夥權益，且於[編纂]時或之後亦不會根據該計劃進一步授出合夥權益。

截至最後實際可行日期，根據僱員激勵計劃授予本公司董事、監事及高級管理層的激勵性獎勵詳情載列如下：

姓名	職位	員工持股計劃 平台的相關 員工持股計劃 權益	員工持股計劃 平台的概約 合夥權益	與參與者持有 的激勵性獎勵 相對應的概約 股份數目	與參與者於緊 接[編纂]前 已發行股份總 數中持有的激 勵性獎勵相對 應的概約持股 百分比	與參與者於緊 隨[編纂]後 已發行股份總 數中持有的激 勵性獎勵相對 應的概約持股 百分比(假設 [編纂] 未獲行使)
董事、監事、高級管理層						
彭光輝先生	首席財務官	鼎弘投資	3.6399%	737,969	0.2032%	[編纂]%
李詠梅女士	副總經理	鼎弘投資	4.5894%	930,475	0.2562%	[編纂]%
李焯星先生	董事會秘書兼 聯席公司秘書	鼎弘投資	1.6617%	336,900	0.0928%	[編纂]%
尹雪芳女士	職工代表監事	旺和投資	1.5187%	128,338	0.0353%	[編纂]%
韓景瑞先生	副總經理兼 研發部總監	鼎弘投資	5.5389%	1,122,980	0.3092%	[編纂]%
其他						
90名僱員	/	/	/	5,096,507	1.4032%	[編纂]%

附錄七

法定及一般資料

F. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或本集團任何成員公司不大可能須承擔任何重大遺產稅責任。

2. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，且據董事所知，並無任何由本集團任何成員公司提出或針對本集團任何成員公司而尚未解決或面臨威脅的重大訴訟或索償。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

獨家保薦人已代表本公司向聯交所申請批准(i)我們根據[編纂]將予發行的H股(包括因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)；及(ii)由非上市股份轉換的H股[編纂]及買賣。

根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘函，我們已同意向獨家保薦人支付其擔任本公司建議H股於聯交所[編纂]的保薦人費用500,000美元。

4. 籌辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大籌辦費用。

5. 發起人

本公司於2022年11月轉制為股份有限公司時的發起人資料載於本文件「歷史、發展及公司架構 — 企業發展 — 本公司 — 2022年11月的股份改制」一節。

除本文件所披露者外，緊接本文件日期前兩年內，本公司概無就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何發起人支付、配發或授出或擬支付、配發或授出現金、證券或其他利益。

附錄七

法定及一般資料

6. 專家資格

於本文件中發表意見的專家資格(定義見上市規則)如下：

名稱	資格
中信證券(香港)有限公司	可進行證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
北京德恒(深圳)律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司	獨立行業顧問
畢馬威會計師事務所	執業會計師及根據《會計及財務匯報局條例》註冊的公眾利益實體核數師
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司	獨立物業估值師
霍金路偉律師事務所	本公司有關國際制裁法的法律顧問

7. 專家同意書

上文所列各方已就刊發本文件發出各自的同意書，同意按本文件所載形式及內容轉載其報告及／或函件及／或意見及引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

於最後實際可行日期，上文所列專家概無於本集團任何成員公司中擁有任何股權或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論是否可依法強制執行)。

附錄七

法定及一般資料

8. H股持有人的稅項

(a) 中國香港

倘H股的出售、購買及轉讓對本公司H股股東名冊造成影響，包括在聯交所進行有關交易的情況下，則該等H股的出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。有關出售、購買及轉讓的現行香港印花稅稅率為所出售或轉讓H股的代價或公平值(以較高者為準)的0.1%。

(b) 諮詢專業顧問

H股的有意持有人如對認購、購買、持有或出售或買賣H股的稅務影響有任何疑問，應諮詢其專業顧問。謹此強調，本公司、董事、監事或參與[編纂]的其他各方概不會就H股持有人因認購、購買、持有或出售或買賣H股或行使H股附帶的任何權利而產生的任何稅務影響或責任承擔任何責任。

9. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，使所有相關人士均受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則條文除外)的約束。

10. 無重大不利變動

董事認為，自2025年5月31日(即本集團最近期經審核綜合財務報表的編製日期)以來，財務或交易狀況並無重大不利變動。

11. 其他事項

除本文件「歷史、發展及公司架構」、「業務」、「財務資料」及「[編纂]」章節以及本節「A.有關本集團的進一步資料」一段所披露者外：

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或擬發行任何繳足或部分已繳股款的股份或貸款資本，以換取現金或現金以外的代價；

附錄七

法定及一般資料

- (ii) 本公司或我們任何附屬公司的股份或貸款資本並無附帶購股權，或有條件或無條件同意附帶購股權；
 - (iii) 並無就發行或出售本公司或我們任何附屬公司的任何股份而授出或同意授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
 - (iv) 概無已付或應付認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債權證的佣金；
- (b) 本公司或我們任何附屬公司概無創始人股份、管理層股份或遞延股份或任何債權證；
- (c) 於本文件日期前12個月內，本集團業務概無發生可能或已對本集團的財務狀況產生重大影響的任何中斷；
- (d) 本公司並無任何尚未行使的可轉換債務證券或債權證；
- (e) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 除就[編纂]將予發行的H股外，概無股本及債務證券於任何其他證券交易所[編纂]或買賣，亦無正在或建議尋求任何[編纂]或批准買賣；
- (g) 本公司目前無意申請中外投資股份有限公司資質，故預期無需遵守《中華人民共和國中外合資經營企業法》；及
- (h) 我們已作出一切所需安排以使H股獲納入[編纂]進行結算及交收。

12. 雙語文件

本文件的中英文版本乃根據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免規定而分別刊發。本文件的英文版本與中文版本之間如有任何不一致之處，概以英文版本為準。